



МИКРОСХЕМА типа И59Н71

ЭТИКЕТКА

Микросхема интегральная И59Н71 предназначена для использования в качестве базовой схемы дифференциального усилителя.

Схема расположения выводов

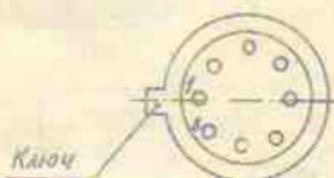


Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода	Номер вывода	Назначение вывода
2	Коллектор VT1	6	Эмиттер VT2
3	База VT1	7	База VT2
4	Эмиттер VT1	8	Коллектор VT2

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при $t = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Продолжение

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Тип микросхемы	Норма	
			не менее	не более
Обратный ток коллектора, нА ($U_{CB} = 20$ В)	I_{CBO}	159HTIA-159HTIE	-	20
Обратный ток эмиттера, нА ($U_{EB} = 4$ В)	I_{EBO}	159HTIA-159HTIE	-	50
Обратный ток коллектор-эмиттер, нА ($U_{CB} = 20$ В, $R_B = 10^4$ Ом)	I_{CEB}	159HTIA-159HTIE	-	50
Ток утечки между транзисторами, нА ($U_{TIT2} = 25$ В)	I_{TTI20}	159HTIA-159HTIE	-	10
Статический коэффициент прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала ($U_{CB} = 5$ В, $f = 50$ Гц $\tau_u = 2$ мс)	$I_E = 1$ мА	h_{2IE}	30	90
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{CB} = 5$ В; $I_E = 3$ мА; $f = 10^3$ Гц)	$I_E = 0,05$ мА	h_{2le}	60	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{CB} = 5$ В; $I_E = 3$ мА; $f = 10^3$ Гц)		h_{2le}	2,5	-

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Тип микросхемы	Норма	
			не менее	не более
Отношение статических коэффициентов прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала ($U_{CB} = 5$ В; $I_E = 1$ мА $f = 50$ Гц; $\tau_u = 2$ мс)	h_{2IE1}	159HTIA, 159HTIB	0,9	-
	h_{2IE2}			
	h_{2ITP}			
	h_{2ITD}			
	h_{2ITB}		0,92	-
	h_{2ITE}		0,8	-
Модуль разности прямых напряжений эмиттер-база, мВ ($U_{CB} = 5$ В; $I_E = 1$ мА)	$ U_{EB1}-U_{EB2} $	159HTIA- 159HTIB	-	3
	$ U_{EB1}-U_{EB2} $	159HTIP- 159HTIE	-	10
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{CB} = 5$ В; $f = 10^7$ Гц)	C_C	159HTIA- 159HTIE	-	3
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{EB} = 1$ В; $f = 10^7$ Гц)	C_E	159HTIA- 159HTIE	-	4

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОСТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ТОРОО ИЗ МИКРОСХЕМ

24,8419 г Зл 999,9

ЗОЛОТО -

в том числе **0,0051 г Зл 999,9**

ЗОЛОТО - 0,00006404 г/мм на 3 вывалах длиной (20±1) мм

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 159НП1 соответствуют техническим условиям
ХМ.466.014 ТУ.

Приняты по извещению №

419-1 17 МАЙ 1991

дата

Штамп ОТК



Штамп представителя
заказчика

Переговорка произведена

дата



дата

Приняты по извещению №

от

Штамп ОТК

Штамп представителя
заказчика